



Toshiba lancia il MOSFET doppio complementare da 30 V che supporta apparecchiature industriali e consumer più compatte e più efficienti dal punto di vista energetico

Il MOSFET a doppio canale N + canale P alloggiato in un package TSOP6F compatto offre una resistenza di on ridotta e ben bilanciata per una progettazione circuitale semplificata

Düsseldorf, Germania, 2 giugno 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») lancia [SSM6L826R](#), un nuovo MOSFET doppio da 30 V che integra sia i MOSFET a canale N che i dispositivi a canale P in un unico package. Il prodotto è ideale per applicazioni che includono il controllo dei motori DC brushless monofase (BLDC), il controllo dei motori DC con spazzole e gli interruttori di carico per le linee di alimentazione nelle apparecchiature di controllo consumer e industriali.

Il dispositivo SSM6L826R utilizza il processo UMOSVIIH di Toshiba per il MOSFET a canale N e il processo UMOSVI per il MOSFET a canale P. È alloggiato in un package TSOP6F compatto (da 2,9 mm × 2,8 mm × 0,8 mm) con cavi piatti per migliorare le prestazioni di montaggio.

Il dispositivo raggiunge bassi valori di resistenza di on al terminale drain-source ($R_{DS(on)}$), pari a 46 mΩ (max.) ($V_{GS} = 10\text{ V}$) per il MOSFET a canale N e 45 mΩ (max.) ($V_{GS} = -10\text{ V}$) per il MOSFET del canale P. Essendo i valori di $R_{DS(on)}$ quasi identici, le perdite di conduzione rimangono ben bilanciate, aiutando i progettisti a semplificare lo sviluppo dei circuiti. Inoltre, l'integrazione di entrambi i tipi di MOSFET in un unico package riduce l'area su PCB, il numero di componenti e il costo della distinta base (BOM).

Con l'introduzione della versione SSM6L826R, Toshiba espande la propria linea TSOP6F di MOSFET duali per includere tre MOSFET doppi a canale N, un MOSFET doppio a canale

P e due MOSFET complementari (N+P), offrendo agli ingegneri una maggiore flessibilità nella selezione del dispositivo ottimale per i propri progetti.

Toshiba continuerà ad espandere il proprio portafoglio di MOSFET in risposta alla crescente domanda di maggiore efficienza, minori perdite e miniaturizzazione spinta delle apparecchiature nei mercati consumer e industriali.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi SSM6L826R, visitare: <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/detail.SSM6L826R.html>

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, di controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre agli hard disk, l'ampio portafoglio dell'azienda comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi discreti che vanno dai diodi ai circuiti integrati logici, ai semiconduttori ottici, ai microcontrollori e ai prodotti standard specifici per un'applicazione (ASSP), tra gli altri. Inoltre, TEE offre anche celle e moduli per batterie SCiB™ con ossido di litio e titanio (LTO) per applicazioni pesanti.

TEE ha la propria sede centrale a Düsseldorf, in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito che forniscono servizi di marketing, vendita e logistica.

Visitate i siti Web di Toshiba all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com e www.scib.jp/en per maggiori informazioni sull'azienda e sui suoi prodotti.

Indirizzo di riferimento per le pubblicazioni:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)7464 493526

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-mail: birgit.schoeniger@pretzl.com